

Výkonové prvky 3,3kV SiC

Výrobce polovodičových součástek společnost Microchip rozšířil portfélio výkonových MOSFET a SBD (Schottky Barrier Diode) o typy pro napětí 3,3kV. Jsou dodávány ve standardních pouzdrech nebo nezapouzdřené (die), které lze použít ve výkonových modulech. Doplňují stávající nabídku výkonových prvků pro napětí 700V, 1200V a 1700V.

[Výkonové moduly](#) ze součástek od Microchipu a ostatních výrobců si lze nechat vyrobit v zákaznickém provedení v Irské továrně Microchipu.



SBD

	V_R	I_F	$V_F @ 25^\circ\text{C}$	T_J	Pouzdro
MSC030SDA330	3300 V	30 A	2,1 V	175 °C	TO-247, Die
MSC090SDA330	3300 V	90 A	2,1 V	175 °C	T-MAX

MOSFET

	V_{DSS}	$I_D @ 100^\circ\text{C}$	R_{DS}	T_J	Pouzdro
MSC025SMA330	3300 V	66 A	25 m Ω	150 °C	Die
MSC027SMA330	3300 V		27 m Ω	150 °C	Die
MSC080SMA330	3300 V	26 A	84 m Ω	150 °C	TO-247-4L
MSC400SMA330	3300 V	7 A	416 m Ω	150 °C	TO-247-4L

Odkazy

Přehled součástek SiC - <https://www.microchip.com/sic>